

2SA995

定電流回路、能動負荷用
シリコンPNPエビタキシャルプレーナ形
デュアルトランジスタ(ベースリード共通)

概 要

2SA995は、シリコンPNPエビタキシャルプレーナ形デュアルトランジスタで、定電流回路、能動負荷用として設計されたものです。特性の良く揃ったトランジスタ2個が樹脂封止形の5ピン・シングルインラインの小形外装に組立てられているので、ステレオのプリアンプ、メインアンプ初段の定電流回路、能動負荷用として最適です。

特 長

- 高耐圧 $V_{CE0} = -100V$
- 低雑音 $NF = 0.6dB$ 標準 (@ $R_G = 1k\Omega$, $I_E = 300\mu A$, $f = 100Hz$)
 $NV = 110mV$ 標準
- ペア特性が良い $I_{C2}/I_{C1} = 0.8 \sim 1.25$
 $|V_{BE1} - V_{BE2}| = 10mV$ 最大
- 直流電流増幅率が高い $h_{FE} = 250 \sim 1200$

用 途

- 定電流回路、能動負荷用

最大定格($T_a = 25^\circ C$)

記 号	項 目	定 格 値	単 位
V_{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	100	V
V_{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	-5	V
V_{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	-100	V
I_C	コレクタ電流	-100	mA
P_C	コレクタ損失($T_a = 25^\circ C$)	200	mW/Unit
P_T	全損失($T_a = 25^\circ C$)	400	mW
T_J	接合部温度	125	$^\circ C$
T_{stg}	保存温度	-55 ~ +125	$^\circ C$

電気的特性($T_a = 25^\circ C$)

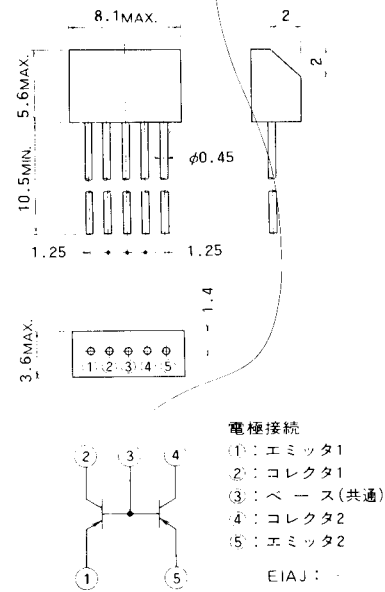
記 号	項 目	測 定 条 件	特 性 値			単 位
			最 小	標 準	最 大	
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = 100\mu A$, $R_{BE} = \infty$	-100			V
I_{CB0}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB} = -100V$, $I_E = 0$			-0.1	μA
I_{CE0}	コレクタしゃ断電流	$V_{CE} = -100V$, $R_{BE} = \infty$			-10	μA
I_{EB0}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB} = -5V$, $I_C = 0$			-0.1	μA
$h_{FE} \uparrow$	直流電流増幅率	$V_{CE} = -6V$, $I_C = -1mA$	250		1200	-
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C = -10mA$, $I_B = -1mA$			-0.3	V
$V_{BE1} - V_{BE2}$	ベース・エミッタ電圧差	$V_{CE} = -6V$, $I_C = -1mA$		1	10	mV
I_{C2}/I_{C1}	コレクタ電流比	$V_{CE} = -6V$, $I_{C1} = -1mA$, 測定回路参照	0.8		1.25	-
f_T	利得帯域幅積	$V_{CE} = -6V$, $I_E = 1mA$		100		MHz
C_{ob}	コレクタ出力容量	$V_{CB} = -6V$, $I_E = 0$, $f = 1MHz$		3		pF
NF	雑音指数	$V_{CE} = -6V$, $I_E = 0.3mA$, $f = 100Hz$, $R_G = 1k\Omega$		0.6		dB
NV	低周波広帯域	$V_{CE} = -10V$, $I_E = 1mA$, $R_G = 100k\Omega$		110		mV
NVM	雑音電圧					
		$G_V = 80dB$, 測定回路参照		0.6		V

†: 素子1の h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	F	G	H
h_{FE}	250 ~ 500	400 ~ 800	600 ~ 1200

外形図

単位: mm



(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。